



**AVVISO N. 072/2013**  
**selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'attribuzione di**  
**n. 1 assegno di ricerca "professionalizzante" (categoria A)**  
**presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia.**

Il Politecnico di Torino intende attribuire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca: **"Sviluppo di sistemi per il controllo e l'integrazione di MEMS e NEMS, di sensori, di sorgenti ottiche, di dispositivi per la diagnostica, di dispositivi di utilizzo industriale"**, di cui alla scheda allegata.

Campo di ricerca:	<b>Technology</b>
Settore Scientifico Disciplinare:	<b>FIS/03 – Fisica della materia</b>
Durata assegno:	<b>1 anno</b> rinnovabile per 3 anni, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista, per esigenze di prosecuzione del programma di ricerca, previa verifica della copertura finanziaria
Importo lordo assegno:	<b>Euro 19.367,00 annui lordi</b>

La domanda di partecipazione alla selezione, *redatta sull'apposito modulo e corredata della documentazione indicata nel bando generale per l'attribuzione di assegni di ricerca*, dovrà essere presentata presso l'Area Risorse Umane, Organizzazione, Trattamenti Economici e Previdenziali - Ufficio Personale non strutturato ed elaborazione dati – stanza n. 3 – **dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**, ovvero inviata tramite fax, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al n. 0110905919, **entro le ore 16.00 del giorno 11.03.2013**. La data di arrivo sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall'ufficio. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.

La selezione verrà effettuata, per titoli e colloquio, secondo il programma d'esame sotto indicato:

<b>Titolo di studio richiesto per la partecipazione:</b>	Diploma di laurea dell'ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 32/S (Ingegneria Elettronica), ovvero 31/S (Ingegneria Elettrica), ovvero 29/S (Ingegneria dell'Automazione)  <i>oppure</i> Laurea in Ingegneria Elettronica, ovvero Laurea in Ingegneria Elettrica, conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 509/1999  <i>oppure</i> titolo universitario straniero equivalente.
<b>Campi su cui dovranno vertere i titoli:</b>	Elettronica; Fisica dei materiali semiconduttori; Tecnologie di crescita di materiali semiconduttori, dielettrici e metallici.
<b>Temi del colloquio:</b>	Il colloquio verterà su: Principi di funzionamento di dispositivi diodi e transistor per applicazioni di potenza; Tecniche di processo per la realizzazione di dispositivi elettronici; Tecniche di analisi di processo e caratterizzazione di materiali.  Saranno, inoltre, discussi i titoli ammessi a valutazione e accertata la conoscenza della lingua inglese e per i cittadini stranieri anche di quella italiana.



## CALENDARIO DELLE PROVE:

<b>Affissione elenco valutazione titoli:</b>	il 20.03.2013 – ore 12,00 alla bacheca del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino – Torino - C.so Duca degli Abruzzi, 24.
<b>Colloquio:</b>	il 20.03.2013 – ore 12,30 presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia - Politecnico di Torino – Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24.

### Titoli:

Sono valutati, purché in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, i seguenti titoli:

- il dottorato di ricerca fino a 10 punti;
- il voto di laurea fino a 5 punti;
- pubblicazioni fino a 15 punti;
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero fino a 10 punti;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca (compresa quella effettuata nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a 20 punti con un massimo di 4 punti all'anno.

Coloro che hanno prodotto domanda dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora su indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.

Il bando generale per l'attribuzione degli assegni di ricerca, cui si rinvia per gli aspetti procedurali, e il "Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" sono disponibili su internet al seguente indirizzo: <http://www.swas.polito.it/services/concorsi/>."

Torino, 27.02.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(P. VIGLIANI)



**Allegato A)**

<p><b>DENOMINAZIONE PROGRAMMA DI RICERCA</b></p> <p>Sviluppo di sistemi per il controllo e l'integrazione di MEMS e NEMS, di sensori, di sorgenti ottiche, di dispositivi per la diagnostica, di dispositivi di utilizzo industriale</p> <p>Development of systems for control and integration of MEMS and NEMS, sensors, optical sources, devices for diagnostics and platforms for industrial application.</p>
<p><b>ACRONIMO PROGRAMMA DI RICERCA</b></p> <p>INTEMNS</p>
<p><b>DURATA E DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA DI RICERCA</b></p> <p>04/05/2012 – 31/04/2017</p>
<p><b>CONTENUTO E FINALITÀ PROGRAMMA DI RICERCA</b></p> <p>L'analisi e lo studio dei processi di fabbricazione dei dispositivi elettronici è di fondamentale importanza per il miglioramento delle prestazioni elettriche, per lo studio dei meccanismi di failure e di affidabilità dei dispositivi stessi.</p> <p>A tal fine occorre utilizzare tecniche di caratterizzazione morfologiche, composizionali, strutturali ed elettriche al fine di correlare le proprietà dei materiali e dei dispositivi realizzati ai parametri di processo utilizzati.</p> <p>Lo scopo dell'attività di ricerca è finalizzato alla analisi dei processi di fabbricazione dei dispositivi prodotti presso Vishay semiconductor nell'ambito della collaborazione in essere con il DISAT.</p> <p>in inglese (max 950 caratteri):</p> <p>The analysis and the study of the processes of fabrication of electronic devices is of fundamental importance for the improvement of the electrical performance, for the study of the mechanisms of failure and reliability of the devices themselves.</p> <p>In order to achieve these goals it is necessary to perform morphological, compositional, structural and electrical characterization in order to study materials and devices properties in order to correlate them to the process parameters.</p> <p>The purpose of the research is aimed at the analysis of the manufacturing processes of semiconductor devices produced at Vishay semiconductor under the cooperation agreement in place with the DISAT.</p>
<p><b>PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'ASSEGNISTA DI RICERCA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ sviluppare, ottimizzare e caratterizzare passi di processo per la realizzazione di dispositivi elettronici di potenza;</li><li>▪ caratterizzare materiali e dispositivi sia su scenari modello da laboratorio che su scenari applicativi reali al fine di avere indicazioni sulla loro affidabilità.</li></ul>